

a 2018 0109

Invenția se referă la tehnologia semiconductoarelor și poate fi utilizată, în special, în dispozitive de conversie a radiației solare în energie electrică.

Procedeul de creștere a structurii  $p^+InP-pInP-n^+CdS$  pentru celule fotovoltaice constă în aceea că se crește stratul de  $pInP$  pe un substrat, executat în formă de plachetă de  $p^+InP$  cu orientarea cristalografică (100), deorientarea de  $3...5^\circ$  în direcția (110) și concentrația purtătorilor de sarcină de  $10^{18} \text{ cm}^{-3}$ , se depune, pe partea frontală a plachetei, prin metoda volumului cvasiînchis stratul de  $n^+CdS$ , se depune pe partea posterioară a plachetei un contact ohmic din  $Ag+5\%Zn$ , se tratează termic la temperatura de  $450^\circ C$ , se depune un contact ohmic din  $In$  pe stratul de  $n^+CdS$ , se tratează termic la temperatura de  $250^\circ C$ , și se depune prin metoda evaporării cu fasciculul de electroni, la temperatura de  $300^\circ C$ , un strat antireflector de  $SiO_2$ .

Revendicări: 1